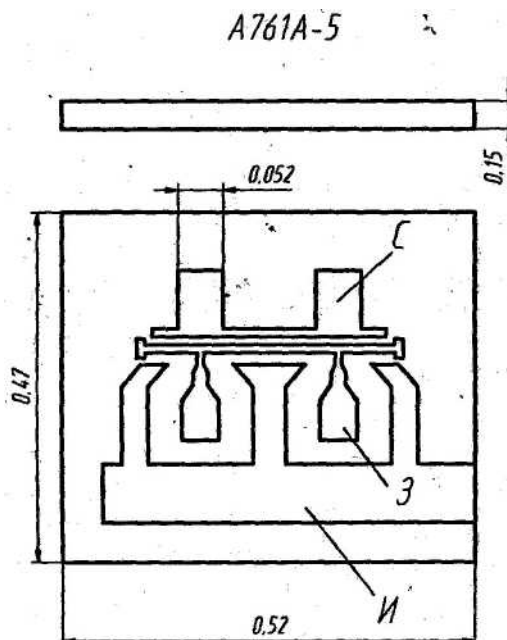


## A761A-5

Транзистор полевой арсенид-галлиевый планарный с затвором в виде барьера Шотки и каналом n-типа генераторный. Предназначен для применения в выходных каскадах усилителей мощности и генераторов в составе гибридных интегральных микросхем. Выпускается в виде кристаллов без кристаллодержателя и без выводов. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,0006 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



### Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 26$ ГГц	
при $U_{с\text{пит}} = 7$ В, $P_{вх} = 44,5$ мВт, не менее .....	0,1 Вт
Коэффициент усиления по мощности на $f = 26$ ГГц	
при $U_{с\text{пит}} = 7$ В, $P_{вх} = 44,5$ мВт, не менее.....	3,5 дБ
Коэффициент полезного действия стока на $f = 26$ ГГц	
при $U_{с\text{пит}} = 7$ В, $P_{вх} = 44,5$ мВт, не менее .....	10%
Коэффициент усиления по мощности в линейной области амплитудной характеристики на $f = 26$ ГГц при ( $U_{с\text{пит}} = 4$ В, $P_{вх} = 5$ мВт, не менее.....	5 дБ
Крутизна характеристики при $U_{си} = 3$ В, $I_c = 50$ мА, не менее .....	20 мА/В
Ток утечки затвора при $U_{зи} = -3,5$ В, не более .....	0,2 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания стока <sup>1</sup> при $T_k = -60...+40$ °С .....	8 В
Постоянная рассеиваемая и средняя рассеиваемая мощность в динамическом режиме <sup>2</sup> :	
$T_k = -60...+40$ °С.....	0,6 Вт
$T_k = +125$ °С.....	0,4 Вт
Температура окружающей среды .....	$-60... T_k = +125$ °С

<sup>1</sup>При  $T_k = +40...+125$  °С  $U_{слит.макс} = 6$  В.

<sup>2</sup> При  $T_k$  от +40 до +125 °С максимально допустимые рассеиваемые мощности снижаются линейно.

Технология сборки транзисторов в гибридной схеме, применяемые детали и материалы должны обеспечивать значение теплового сопротивления собранного в гибридную схему транзистора не более +200 °С /Вт.

При монтаже транзисторов в составе гибридных схем необходимо выполнять следующие условия: монтаж рекомендуется осуществлять с помощью клея ЭЧЭ-С ТУ БУО.028.052. Температура сушки +120 ± 10 °С, время сушки 90 ± 15 мин;

термокомпрессионное присоединение к контактным площадкам истока транзистора рекомендуется осуществлять перемычкой из золотой фольги Зл999,9 размером 0,7\*0,4 мм;

присоединение выводов к контактным площадкам рекомендуется производить термокомпрессионной сваркой при температуре +310 ± 20 °С. В качестве вывода должна применяться золотая проволока Зл999,9;

соединение вывода с контактной площадкой должно выдерживать разрывное усилие не менее 0,6 гс; выводы после термокомпрессионной сварки не должны касаться планарной структуры транзистора и боковых ребер кристалла. Не допускается смещение термокомпрессионных точек, приводящее к закорачиванию элементов структуры. Не допускается сильное натяжение и провисание выводов. Не допускается разрыв, пережатие в месте термокомпрессионной сварки. Не допускается затекание клея по периметру кристалла.

После извлечения транзисторов из герметичной или влагозащитной упаковки изготовителя до присоединения выводов к контактным площадкам транзисторы должны находиться в специальной камере с инертной средой не более 10 сут.

При эксплуатации транзисторов в усилительных схемах следует учитывать возможность их самовозбуждения, как высокочастотных элементов, и принимать меры к его устранению.